

CS39-4B
CS39-4D
CS39-4M
CS39-4N

**SILICON CONTROLLED RECTIFIER
4 AMP, 200 THRU 800 VOLTS**



TO-39 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CS39-4B series types are hermetically sealed silicon controlled rectifiers designed for sensing circuit applications and control systems.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL	CS39 -4B	CS39 -4D	CS39 -4M	CS39 -4N	UNITS
Peak Repetitive Off-State Voltage	V_{DRM}, V_{RRM}	200	400	600	800	V
RMS On-State Current ($T_C=90^\circ\text{C}$)	$I_T(\text{RMS})$		4.0			A
Peak One Cycle Surge Current ($t=10\text{ms}$)	I_{TSM}		35			A
I^2t Value for Fusing ($t=10\text{ms}$)	I^2t		4.5			A^2s
Peak Gate Power Dissipation ($t_p=10\mu\text{s}$)	P_{GM}		3.0			W
Average Gate Power Dissipation	$P_{G(AV)}$		0.2			W
Peak Gate Current ($t_p=10\mu\text{s}$)	I_{GM}		1.2			A
Operating Junction Temperature	T_J		-40 to +125			$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}		-65 to +150			$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	Θ_{JA}		180			$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance	Θ_{JC}		10			$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

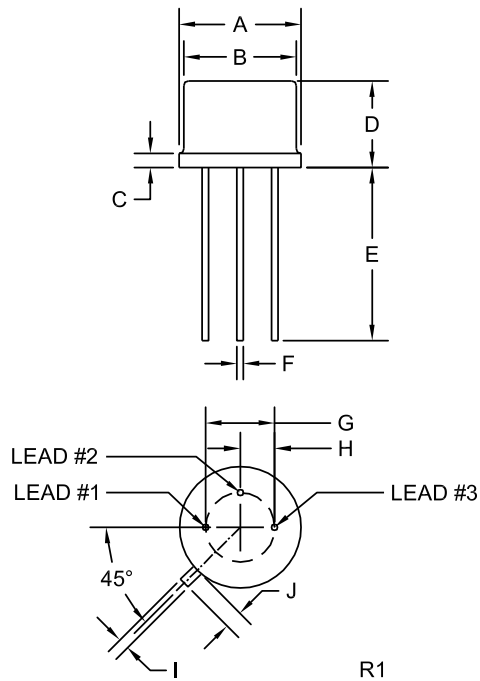
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{DRM}, I_{RRM}	Rated $V_{DRM}, V_{RRM}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega$			5.0	μA
I_{DRM}, I_{RRM}	Rated $V_{DRM}, V_{RRM}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega, T_C=125^\circ\text{C}$			200	μA
I_{GT}	$V_D=12\text{V}, R_L=10\Omega$		38	200	μA
I_H	$I_T=50\text{mA}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega$		0.25	5.0	mA
V_{GT}	$V_D=12\text{V}, R_L=10\Omega$		0.55	0.8	V
V_{GD}	$V_D=300\text{V}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega, T_C=125^\circ\text{C}$	0.2			V
V_{TM}	$I_T=8.0\text{A}, t_p=380\mu\text{s}$		1.6	1.95	V
dv/dt	$V_D=\frac{2}{3}V_{DRM}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega, T_C=125^\circ\text{C}$	10			$\text{V}/\mu\text{s}$

CS39-4B
CS39-4D
CS39-4M
CS39-4N

SILICON CONTROLLED RECTIFIER
4 AMP, 200 THRU 800 VOLTS



TO-39 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A (DIA)	0.335	0.370	8.51	9.40
B (DIA)	0.315	0.335	8.00	8.51
C	-	0.040	-	1.02
D	0.240	0.260	6.10	6.60
E	0.500	-	12.70	-
F (DIA)	0.016	0.021	0.41	0.53
G (DIA)	0.200		5.08	
H	0.100		2.54	
I	0.028	0.034	0.71	0.86
J	0.029	0.045	0.74	1.14

TO-39 (REV: R1)

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Gate
- 3) Anode

MARKING: FULL PART NUMBER

R3 (19-September 2012)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru